

# DS442



1080

シリコンエピタキシャルプレーナ形

## 超高速スイッチングダイオード

©713D

特長 - ガラススリーブ構造。

- 許容損失 :  $P=300\text{mW max.}$

- 端子間容量 :  $c=3.0\text{pF max.}$

- 逆回復時間 :  $t_{rr}=4.0\text{ns max.}$

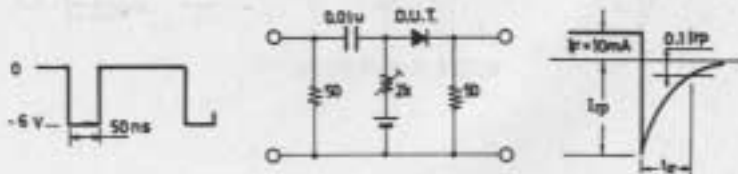
保守品

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings /  $T_a=25^\circ\text{C}$

|        |                     |            | unit             |
|--------|---------------------|------------|------------------|
| セム順逆電圧 | $V_{RM}$            | -35        | V                |
| 逆電圧    | $V_R$               | -30        | V                |
| セム順電流  | $I_{FM}$            | 360        | mA               |
| 平均整流電流 | $I_O$               | 120        | mA               |
| サージ順電流 | $I_{FSM}$ 1 sec パルス | 500        | mA               |
| 許容損失   | $P$                 | 300        | mW               |
| 接合部温度  | $T_j$               | 175        | $^\circ\text{C}$ |
| 保存周囲温度 | $T_{stg}$           | -65 ~ +175 | $^\circ\text{C}$ |

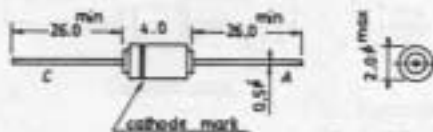
電気的特性 Electrical Characteristics /  $T_a=25^\circ\text{C}$

|       |          |   | min  | typ | max  | unit          |
|-------|----------|---|------|-----|------|---------------|
| 順電圧   | $V_{F1}$ | $I_F=1.5\text{mA}$                              | 0.55 |     | 0.68 | V             |
|       | $V_{F2}$ | $I_F=50\text{mA}$                               |      |     | 1.0  | V             |
| 逆電流   | $I_R$    | $V_R=-30\text{V}$                               |      |     | -1.0 | $\mu\text{A}$ |
| 端子間容量 | $c$      | $V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$                  |      |     | 3.0  | pF            |
| 逆回復時間 | $t_{rr}$ | $V_R=-6\text{V}, I_F=10\text{mA}, R_L=50\Omega$ |      |     | 4.0  | ns            |



逆回復時間測定回路

外形図 1080  
(unit: mm)



C: Cathode  
A: Anode